國立交通大學 97 學年度碩士班考試入學試題

科目:半導體材料與製程技術相關課題(8101)

考試日期:97年3月9日第4節

系所班別:工學院碩士在職專班 組別:半導體材料與製程設備組

第 1 頁,共 3

【可使用計算機】*作答前請先核對試題、答案卷(試卷)與准考證之所組別與考科是否相符!!

下列考題共十一題,任選五題做答,每題佔20%,總分100分;做答 5 題以上者,以較低分之五題計算總分。請在答案卷中標示所選答之 題號。

- 1. 從能階觀點解釋為何過去 IC 製程避免銅污染?解釋銅在矽晶圓為 何擴散較快(何種擴散機制)?試解釋為何目前IC製程需使用銅導線? 說明目前IC 製程在實際管理面及製程設計面如何解決上述問題?
- 2. 試繪出同時以離子佈值 B 及 Sb 至 Si 基板時在同操作佈值電壓 下,其離子在 Si 基板內之深度分佈狀況(假設二者佈值濃度相同), 並繪出兩種不同離子所造成之晶格傷害隨深度之分佈。此二種離 子何者造成之傷害較大?為什麼?在活化後,此晶片為ntype或p type?或部分為 n type, 部分為 p type?試解釋之?
- 3. 下圖為 GaAs 及 Si 電場對電子漂移速度(drift velocity)之簡圖:

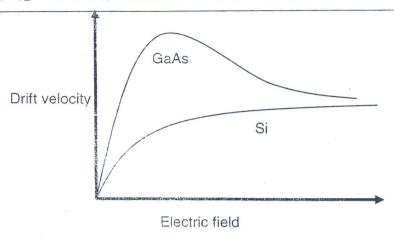
國立交通大學 97 學年度碩士班考試入學試題

科目: 半導體材料與製程技術相關課題(8101)

考試日期:97年3月9日第4節

系所班別:工學院碩士在職專班 組別:半導體材料與製程設備組 第 2 頁,共 3 頁

【可使用計算機】*作答前請先核對試題、答案卷(試卷)與准考證之所組別與考科是否相符!!



- (1)何者電子遷移率大?
- (2)為何 Si 之 drift velocity 會有飽和現象?
- (3)寫出電子邊移率、電子漂移速度、電場三者之關係。
- (4)為何 GaAs 漂移速度在高電場有下降現象?
- (5)在低電場操作時,使用何者材料較佳?有那些優點?
- 4. 請說明光電效應(photoelectric effect)的原理,在量子力學理論中, 此效應說明了電磁波的何種性質?
- 5. 如果要分析銅製程中之擴散阻障層(diffusion barrier)之厚度組成與 覆蓋率(step coverage),可用哪些分析方法?相關之基本原理與試 片製備之步驟為何?
- 6. 掃描式電子顯微鏡(SEM)技術為常用之材料分析方法,敘述 SEM 影像對比跟電子東之電流關係及影響倍率或是影像解析度(spatial resolution)之原因。
- 7. 磊晶成長出之寬能隙半導體薄膜中常見之缺陷為何,形成之機制 為何?應如何分析,其原理為何?

國立交通大學 97 學年度碩士班考試入學試題

科目:半導體材料與製程技術相關課題(8101)

考試日期:97年3月9日第4節

系所班別:工學院碩士在職專班 組別:半導體材料與製程設備組

第 3 頁,共 3

【可使用計算機】*作答前請先核對試題、答案卷(試卷)與准考證之所組別與考科是否相符!!

- 8. (a) 蝕刻製程有哪些需求?
 - (b) 以乾蝕刻金屬為例, 需考量哪些需求?
- 9. (a) 試依序簡述微影區各製程之功能。
 - (b) 微影區製程何者可以為晶圓軌道系統(Track system)內製程? 各製程參數為何?
- 10. 何謂 Vacuum Robot? 而 Vacuum Robot 會用在哪些半導體製程設 備中(舉三種設備)? 請說明 Vacuum Robot 一般所需的運動動 作? 而 Vacuum Robot 在設計上必須考慮哪些限制(至少三項)?
- 11. 請問化學機械研磨(CMP)設備在半導體製程中提供的功能特點為 何?請簡憂說明 CMP 設備的研磨機制及其主要的組成模組。請舉一 個在 CMP 設備中用來做為研磨終點量測的方法。